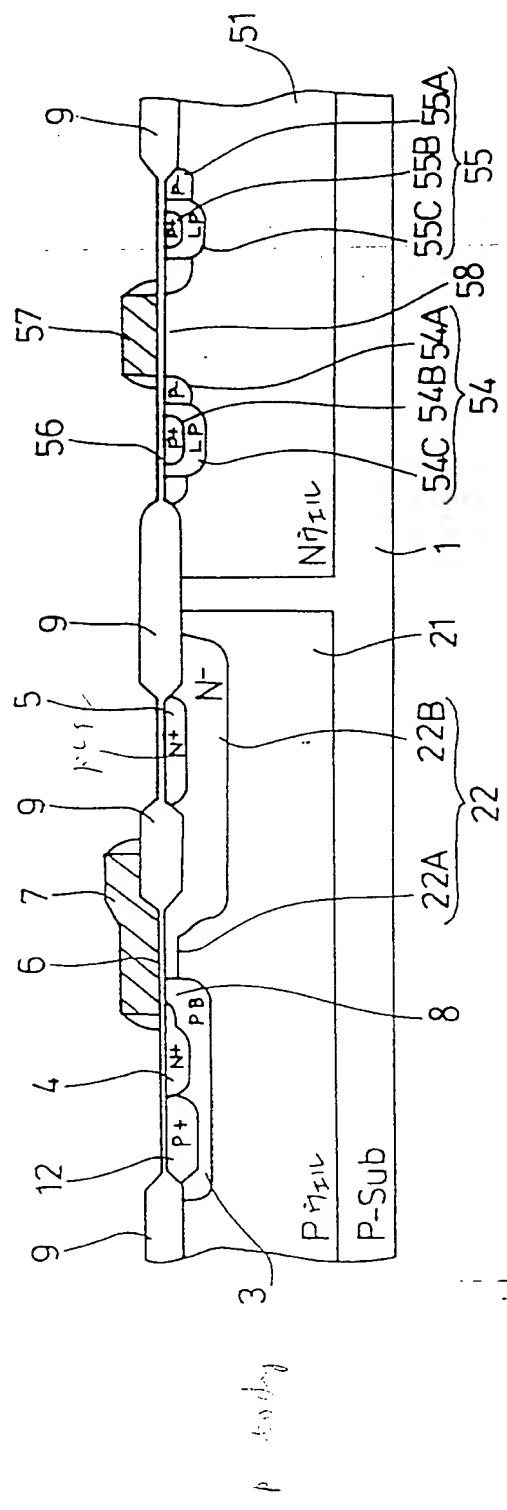


FIG.1

(A) (B)



- 21: P型ウェル領域
- 22A: 第1のN層
- 22B: 第2のN層
- 22: N層 (ドリフト領域)
- 51: N型ウェル領域
- 54, 55: P型拡散領域
- 56: H⁺-ト絶縁膜
- 57: H⁺-ト電極
- 58: チャネル領域

FIG. 2A

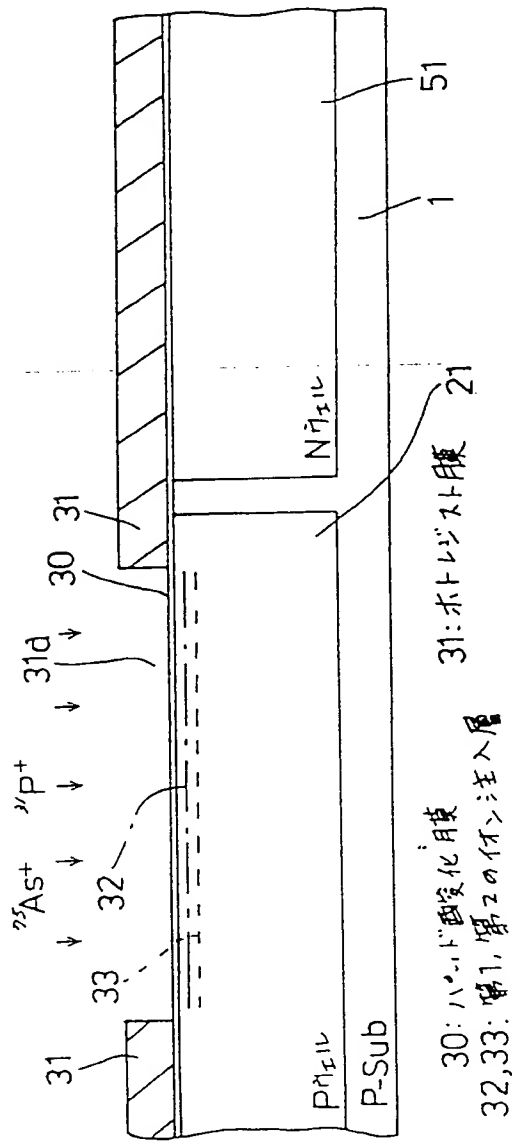
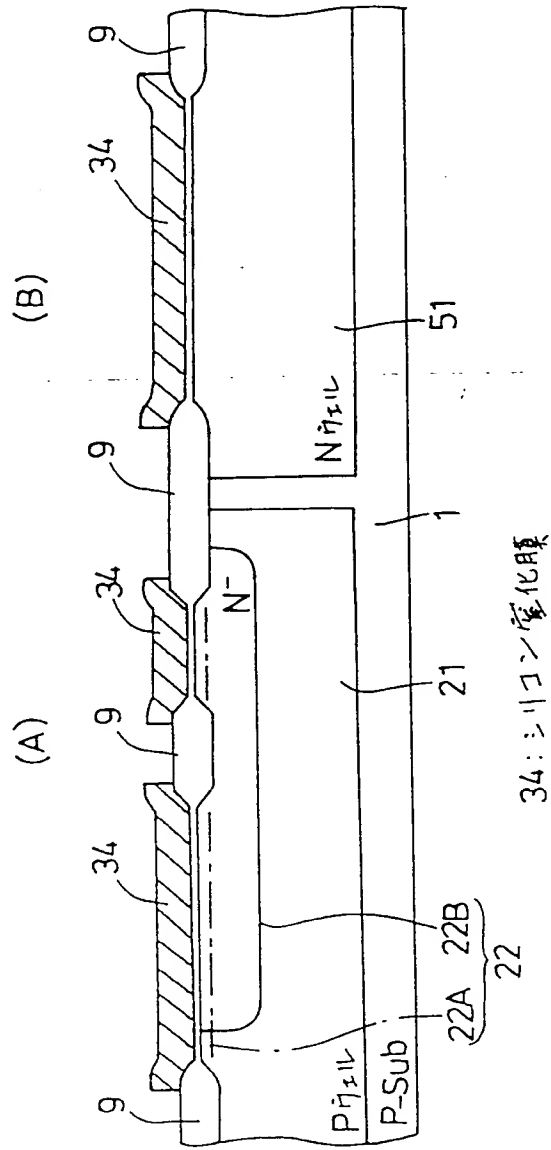


FIG. 2B



SECRET

3/22

提出日 平成10年12月10日

整理番号=K1A0980196

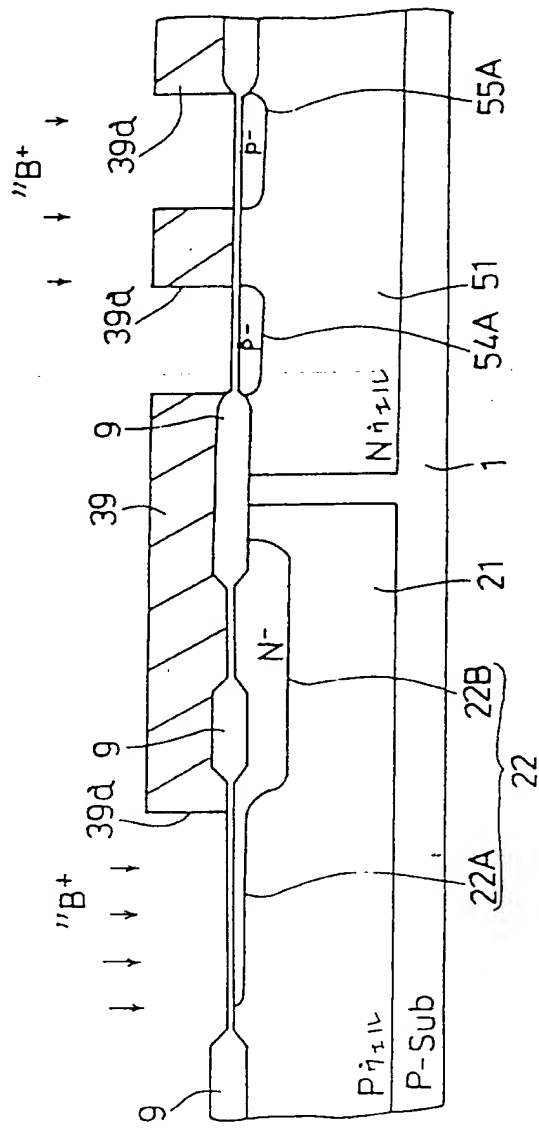


FIG. 3A

39:ホトリレジスト膜

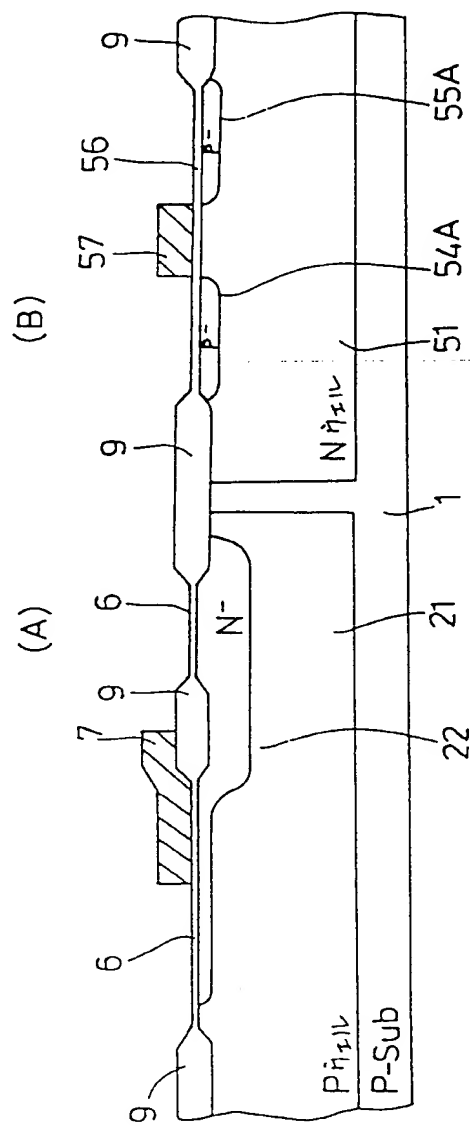


FIG. 3B

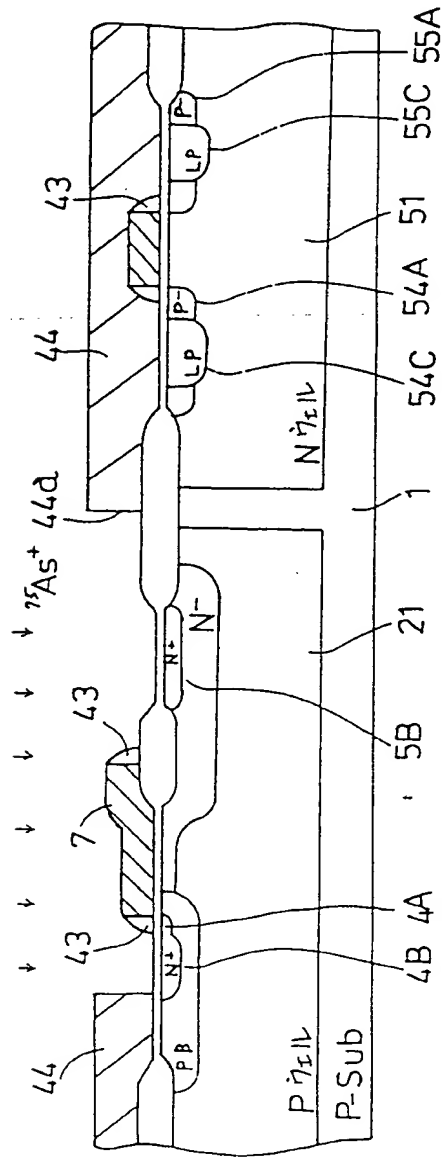
[illegible]

FIG. 5A:

43: サイドウォールスペース膜

(A) $49 \frac{1}{2}$ (B)

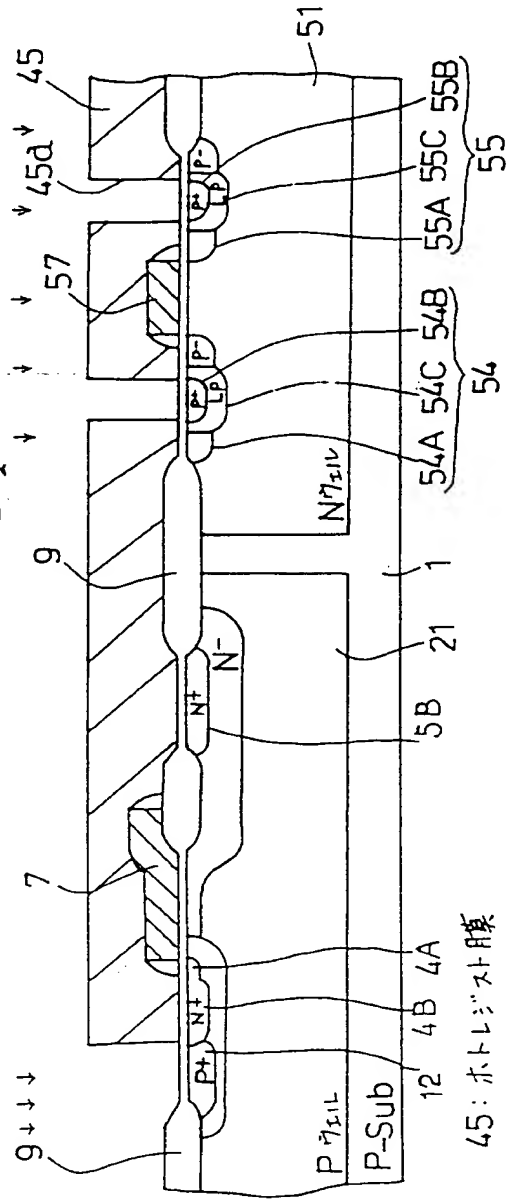


FIG. 5B

45: ホトリジスト膜

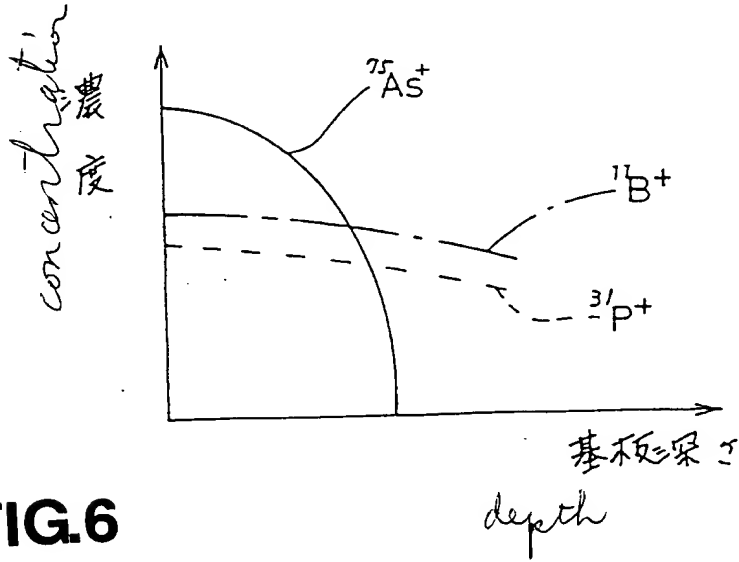
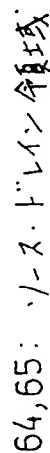


FIG.6

Figure 1. The 1000-bp DNA fragments amplified from the *hprt* gene of the 1000 clones. The fragments were separated by 1% agarose gel electrophoresis. The bands were stained with ethidium bromide and visualized under short wave UV light. The bands were numbered 1 to 1000 according to the order of the clones. The bands were numbered 1 to 1000 according to the order of the clones.

(B)



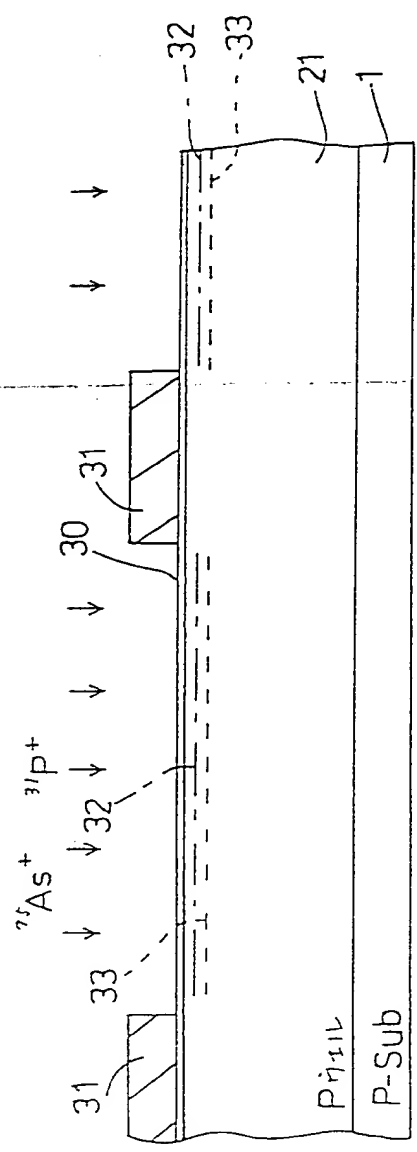
9/22

提出日 平成10年12月 4日

整理番号=KIA0980186

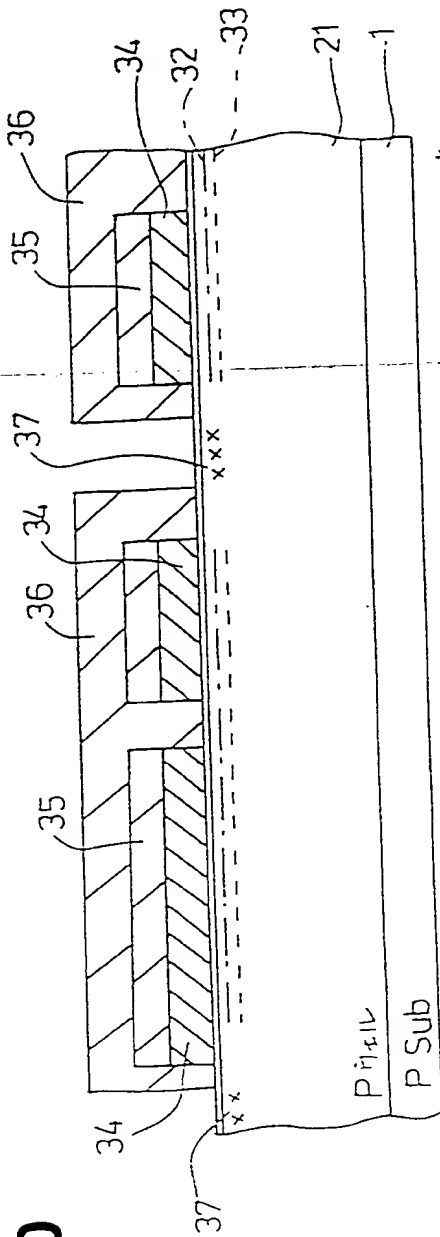
9

FIG.9



30: パッド酸化膜 31: ホトレジスト膜
32, 33: 第1, 第2のイオン注入層

FIG. 10



34: シリコン窒化膜	35, 36: 第1, 第2のホトレジスト膜
37: ナノレジストパターンの形成用注入層	

11/22

提出日 平成10年12月 4日

特許番号=K I A 0 9 8 0 1 8 6

//

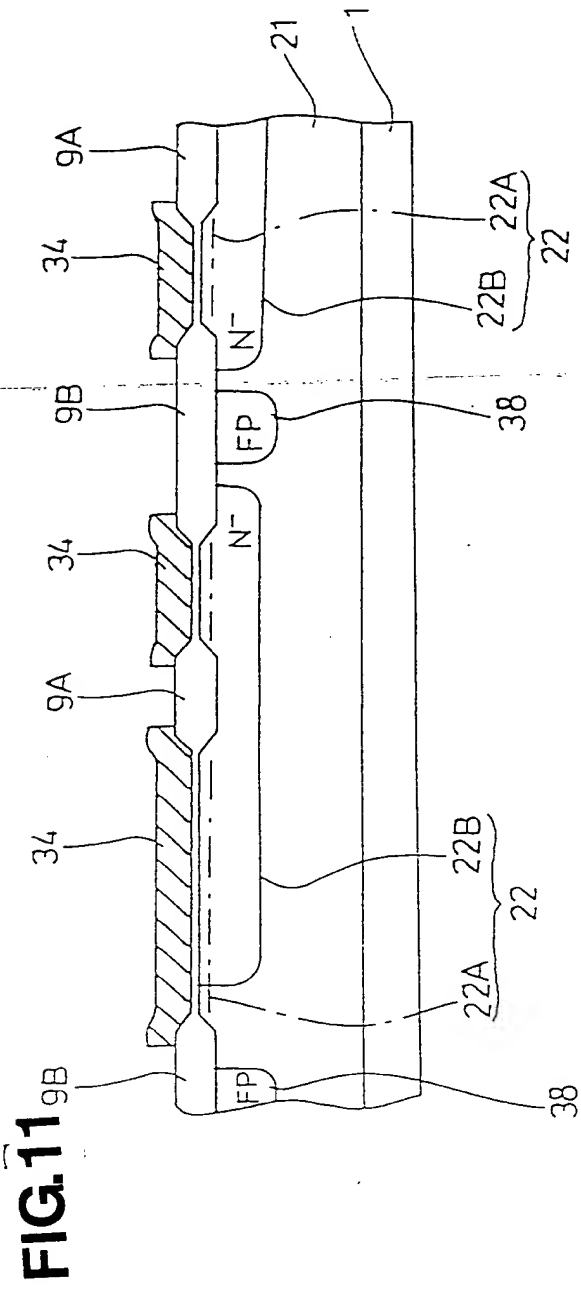


FIG. 11

9B

FIG. 11

9B

34

9A

34

9B

34

9A

FP

22A

22B

N⁻

FP

N⁻

22A

22B

22

38

38

22A

22B

22

38

22A

22B

22

38

21

1

9A

9B

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

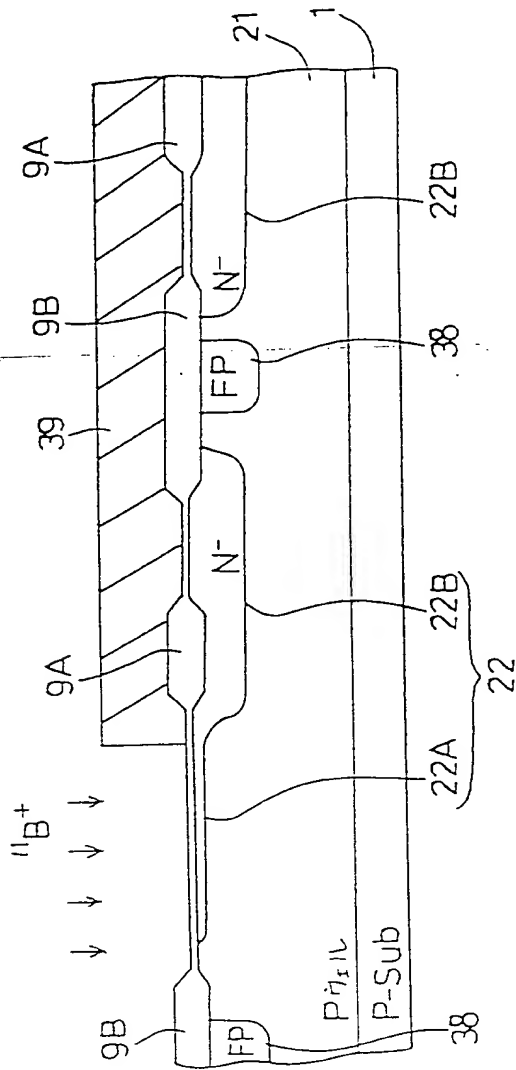
34

34

34

34

FIG. 12



39: ホト1: "ストロブ"

13/22

提出日 平成10年12月 4日

特許出願番号=K1A0980186

2

60227-671160

60

60

FIG.13

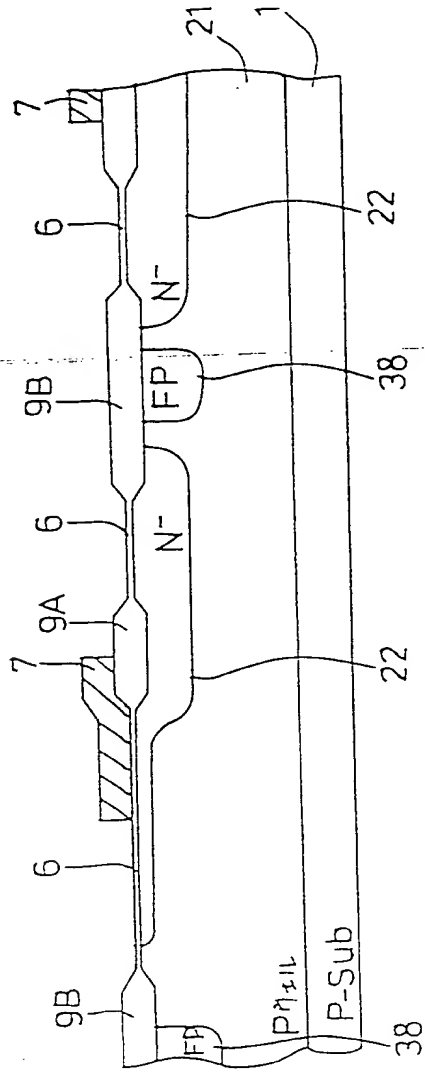
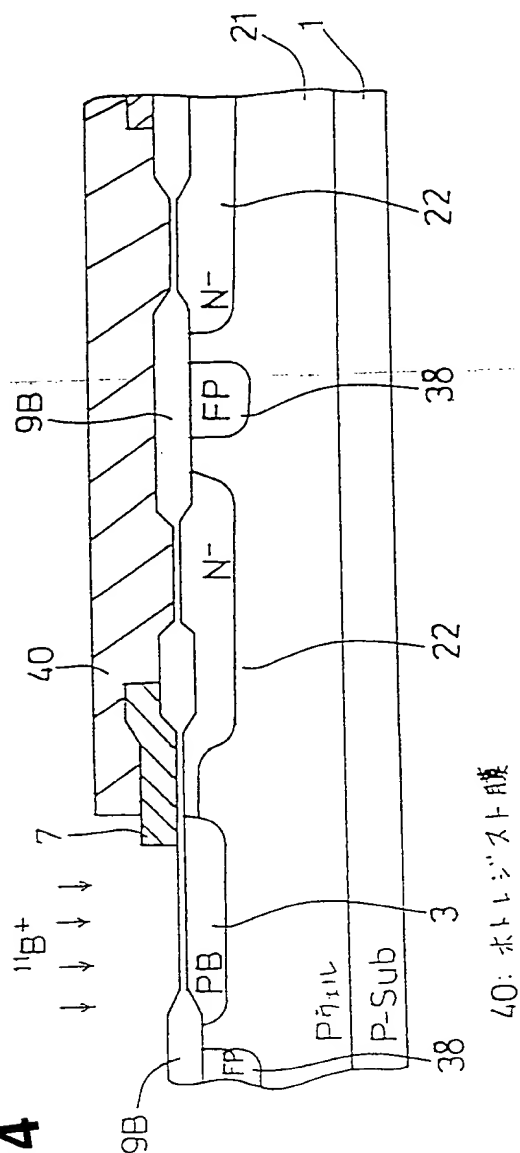


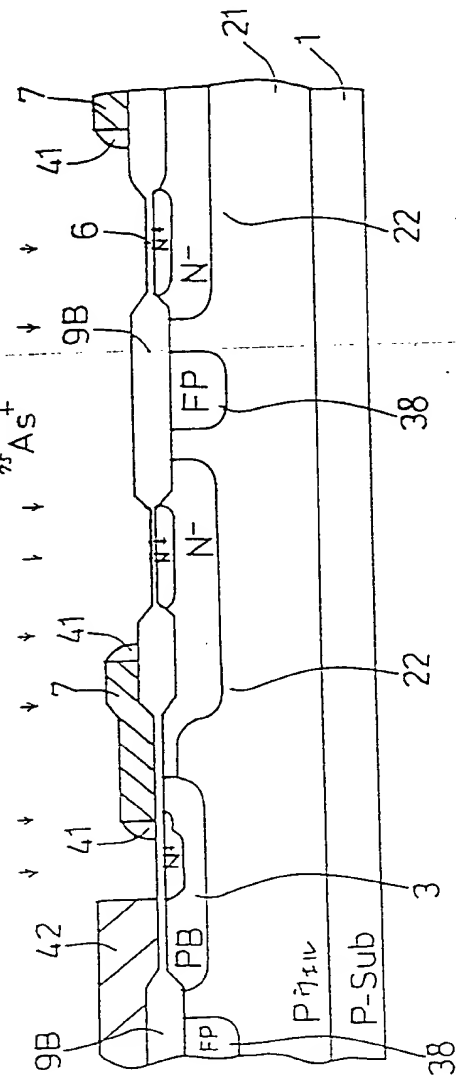
FIG.14



15/22

提出日 平成10年12月 4日

整理番号=KIA0980186



41: ガイドホール スペース膜 42: ホトリジスト膜

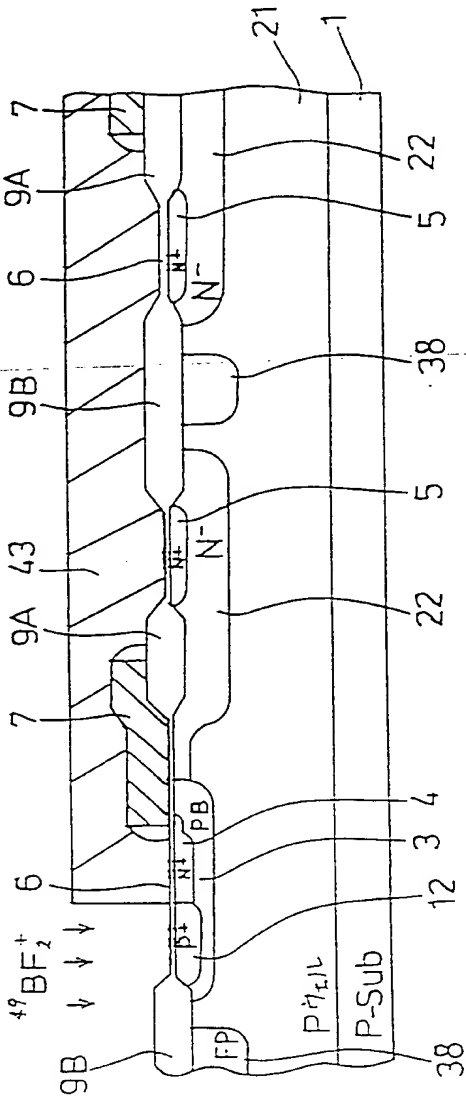
FIG.15

16/22

提出日 平成10年12月 4日

整理番号=KIA0980186

16



43: ホトリジスト膜

FIG.16

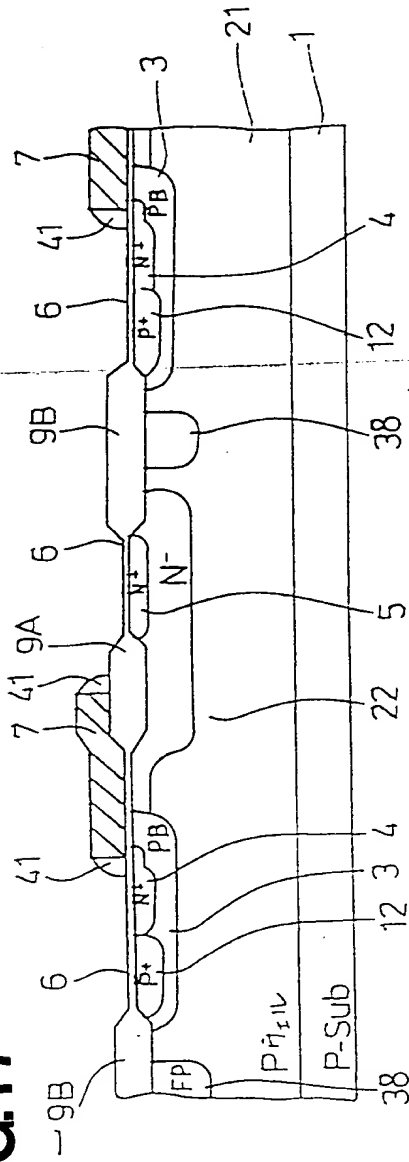
17/22

提出日 平成10年12月 4日

発明番号=K1A0980186

17

FIG.17



18/22

提出日 平成10年12月10日

整理番号=K I A 0 9 8 0 1 9 6

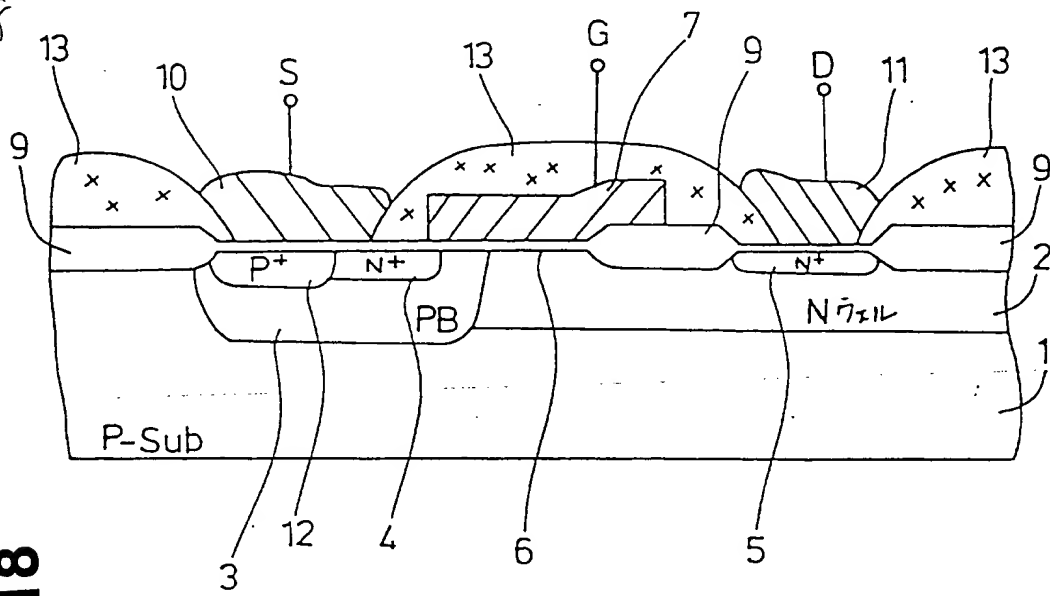


FIG.18

00221-01811100

19/22

提出日 平成10年12月10日

整理番号=K I A 0 9 8 0 1 9 6

19

FIG.19A

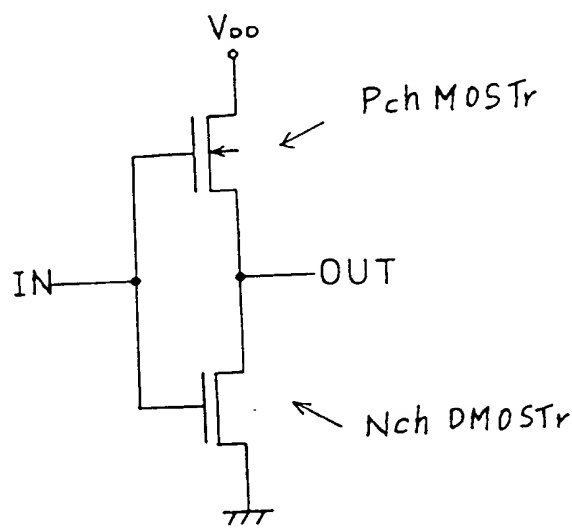
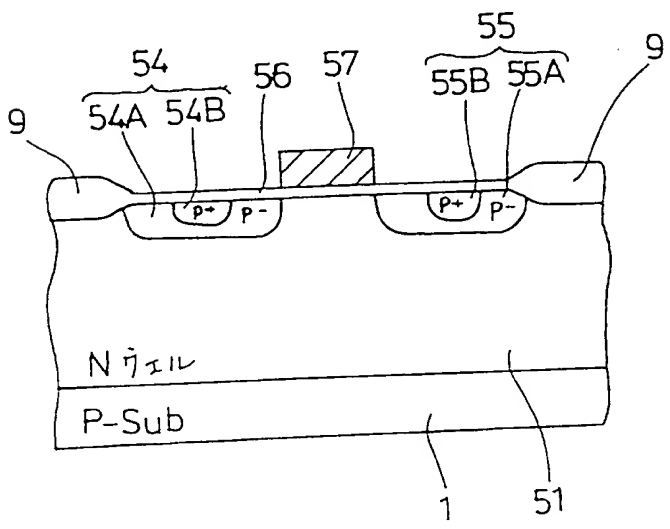


FIG.19B



【図 1-2】

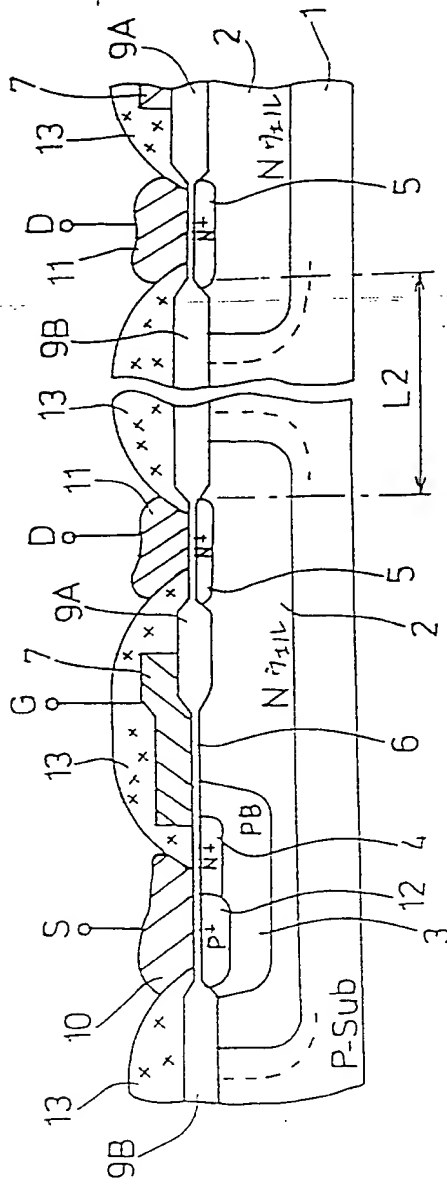


FIG. 20

21/22

SECRET

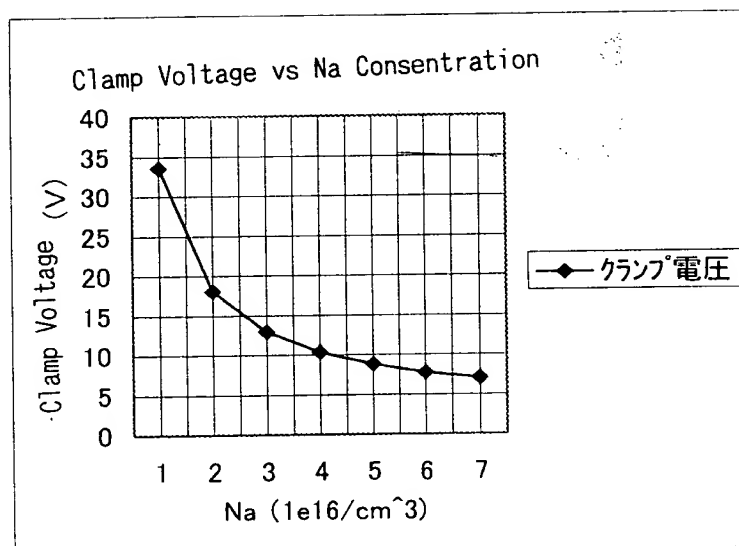


FIG.21

N-Clamp Voltage vs Na Concentration
 Stepped Junction N-Concentration $1 \times 10^{17}/\text{cm}^3$
 $X_j = 0.2 \mu\text{m}$

22/22

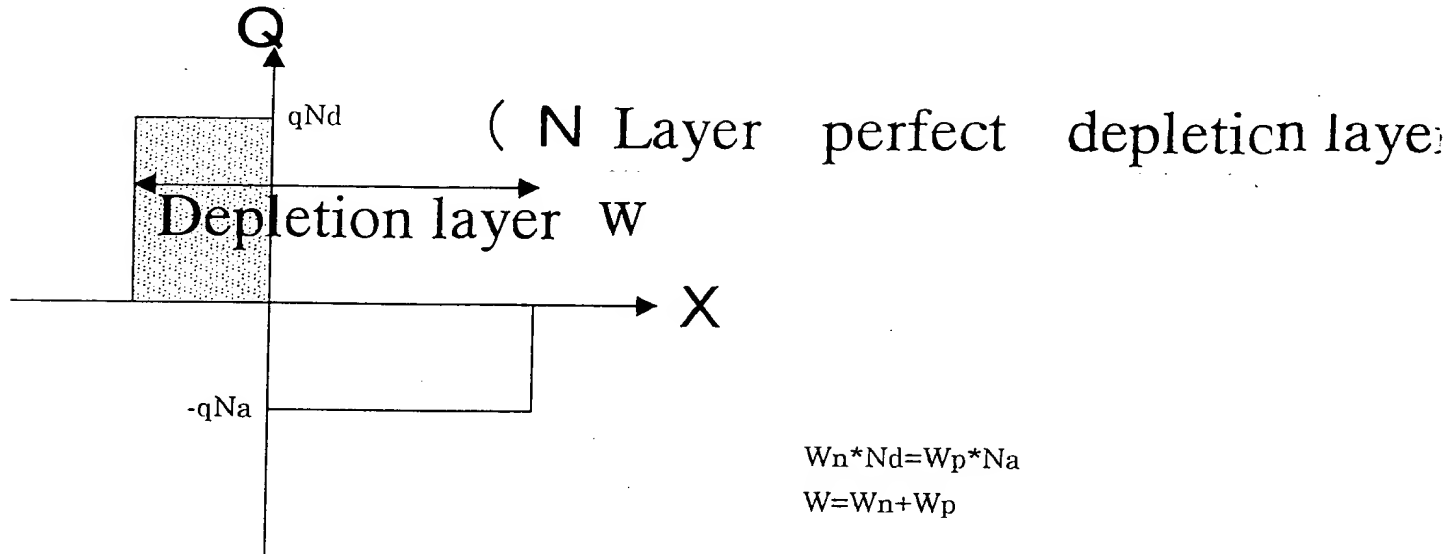
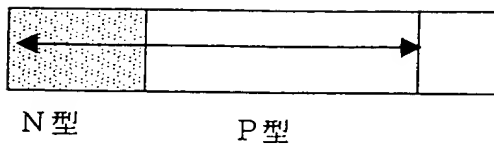


Fig.22 Stepped Junction